

Коэффициент связи для результатов рис. 2 меньше критического, что подтверждается уменьшением измеряемого значения $2\Delta f$ при росте к. с. в. Собственная добротность вычисляется по формуле [7]

$$Q = \frac{f}{2\Delta f} \left(1 + \frac{1}{\text{к. с. в.}} \right)$$

и составляет $(0.8 \div 1.14) \cdot 10^5$ единиц, что по порядку величины согласуется с теоретическими оценками, следующими из результатов [6].

Продольный и поперечный индексы данной моды можно оценить, анализируя крутизну перестроенной характеристики (зависимости резонансной частоты от длины резонатора). Измерения показывают, что для высокодобротных мод $n=15 \div 25$, $m=1 \div 2$, что соответствует оговоренным выше условиям малого поглощения, следующим из теоретического анализа.

Отметим, что кривые рис. 2 сняты при фиксированном положении возбуждающего штыря. За пределами диапазонов частот, в которых измерены $2\Delta f$ для каждой из мод, к. с. в. существенно возрастает и следует производить подрегулировку связи перемещением штыря.

Согласование в широком диапазоне частот без подрегулировки связи может быть достигнуто путем перехода с моды на моду аналогично тому, как это сделано в [8] применительно к обычным полым резонаторам. Данный резонатор может быть использован в экспериментальной физике (спектроскопия электронного парамагнитного резонанса, измерение материальных параметров твердых тел и т. д.), электронике СВЧ (релятивистские генераторы дифракционного излучения), измерительной технике (вольномеры). Дальнейшее повышение Q возможно при увеличении n , улучшении качества обработки поверхности либо использовании средств криогенной техники.

Литература

- [1] Вайнштейн Л. А. Открытые волноводы и открытые резонаторы. М.: Сов. радио, 1966, 474 с.
- [2] Шестопалов В. П. Физические основы миллиметровой и субмиллиметровой техники. Киев: Наукова думка, 1985, т. 1. 216 с.
- [3] Штейншлайер В. Б. Явления взаимодействия волн в электромагнитных резонаторах. М.: Оборонгиз, 1955. 112 с.
- [4] Claricoats P. J. B., Oliver A. D., Chong S. L. Proc. IEE, 1975, v. 122, N 11, p. 1173—1186.
- [5] Альховский Э. А., Ильинский А. С. и др. Гибкие волноводы в технике СВЧ. М.: Радио и связь, 1986. 127 с.
- [6] Ильинский А. С., Слепян Г. Я. Колебания и волны в электродинамических системах с потерями. М.: МГУ, 1983. 231 с.
- [7] Валитов Р. А. Радиотехнические измерения. М.: Сов. радио, 1963. 632 с.
- [8] Родионова В. Н., Нехай А. К. Исследование возможности создания высокодобротных объемных резонаторов — техника средств связи. Радиоизмерительная техника. 1981, в. 5, с. 39—44.

Поступило в Редакцию
28 ноября 1986 г.

Журнал технической физики, т. 58, в. 3, 1988

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМАЯ ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ НА ФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ КРИСТАЛЛЫ

B. M. Петров, A. B. Хоменко, M. B. Красинькова

К настоящему времени предложено несколько типов оптически управляемых пространственно-временных модуляторов света (ПВМС), в которых в качестве модулирующей среды используются различные электрооптические материалы. Это ПВМС типа ПРИЗ, ПРОМ, ЭПОС, ФОТОТИТУС, структуры МДП—ЖК [1—3]. Их основное назначение — ввод информации в тракт когерентной оптической обработки [1]. Запись информации на таких ПВМС осуществляется в виде пространственно-неоднородной плотности заряда $\rho(x, y, z)$, которая формируется вблизи поверхности электрооптического кристалла под действием двух факторов: а) засветки рабочей поверхности модулятора записывающим светом, интенсивность которого определенным образом промодулирована записываемым сигналом; б) приложением

к структуре модулятора рабочего напряжения. В случае указанных ПВМС рабочие напряжения составляют десятки вольт для структур МДП-ЖК, 100–200 В для модулятора ФОТОТИТУС и 1–2 кВ для модуляторов ПРИЗ, ПРОМ.

В ряде задач необходимо ввести в тракт когерентно-оптической обработки информацию, которая исходно представлена в виде электрических сигналов.

В данной работе показана возможность электрически управляемой записи информации с помощью светочувствительных структур на основе фоторефрактивных кристаллов типа $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$, которые ранее использовались в оптически управляемых ПВМС типа ПРИЗ и ПРОМ. Исследовалась структуры модуляторов, предназначенные для электрически управляемой записи одно- и многоканальных электрических сигналов.

Для пояснения принципа электрически управляемой записи рассмотрим неоднородную плотность заряда $\rho(x, y)$ в кристаллической пластине, которую в линейном приближении можно записать в виде

$$\rho(x, y) = A \int_0^{\tau} I(x, y, t) U(x, y, t) dt. \quad (1)$$

Здесь $I(x, y, t)$ — функция засветки модулятора записывающим светом; $U(x, y, t)$ — напряжение, прикладываемое к модулятору; интервал времени $[0, \tau]$ определяет длительность

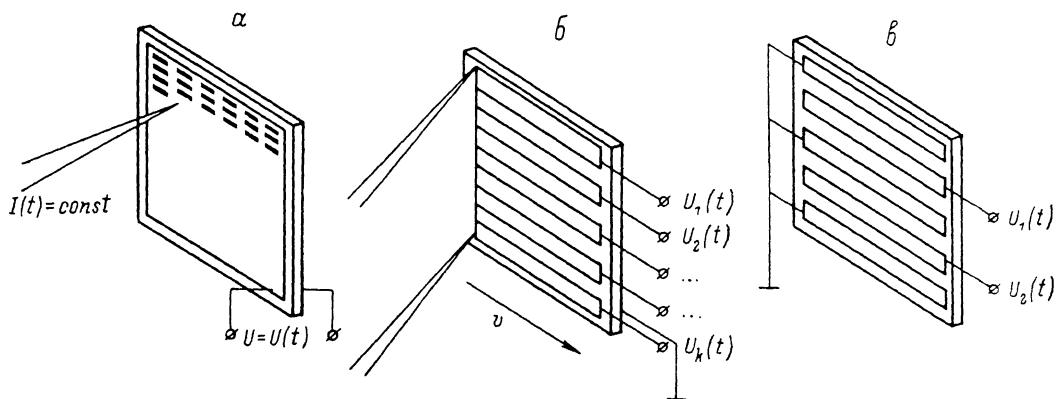


Рис. 1. Исследованные структуры модуляторов для электрически управляемой записи: одноканальная запись двумерного сигнала (ПВМС типа ПРИЗ) (а) и многоканальная запись при поперечном (б) и продольном (в) управляющем поле.

экспозиции модулятора; коэффициент A — эффективность формирования заряда. Зависимость ρ от координаты z связана с механизмом формирования заряда и в данном случае не рассматривается.

Выражение (1) позволяет с функциональной точки зрения рассмотреть различные варианты записи информации на ПВМС. Например, при оптически управляемой записи $U(x, y, t)$ постоянно и однородно во время экспозиции. Имеются два основных варианта оптической записи: 1) параллельный, когда на ПВМС записывается весь входной двумерный массив информации (изображение); 2) последовательный (растровый), когда запись информации на ПВМС происходит последовательно, точка за точкой. При оптически управляемой параллельной записи $I(x, y, t)$ не зависит от времени в процессе записи. В случае последовательной (растровой) записи $I(x, y, t)$ представляет бегущее по апертуре модулятора световое пятно, промодулированное записываемым сигналом по времени, что и позволяет делать последовательную одноканальную оптическую запись изображения.

Однако, как видно из формулы (1), неоднородная плотность заряда $\rho(x, y)$ интегрально зависит от произведения двух функций: $I(x, y, t)$ и $U(x, y, t)$. Следовательно, $\rho(x, y)$ может быть сформирована не только за счет модуляции интенсивности записывающего света $I(x, y, t)$, но и путем вариаций прикладываемого напряжения $U(x, y, t)$. Это и позволило в данной работе осуществить электрически управляемую запись.

Пример одноканальной электрически управляемой записи двумерного массива на ПВМС ПРИЗ показан на рис. 1, а. В этом случае по рабочей поверхности модулятора движется пятно света из сине-зеленой области спектра, интенсивность которого постоянна, а к электродам модулятора прикладывается напряжение, соответствующее амплитуде электрического

сигнала. Движущееся световое пятно производит локальное «очувствление» модулятора к управляющему электрическому сигналу. При этом если в момент прохождения заданной точки (x_0, y_0) к электродам было приложено напряжение $U(t)$, то, согласно (1), плотность заряда $\rho(x_0, y_0)$ будет пропорциональна величине $U(t)$.

На рис. 1, б, в показаны конструкции модуляторов, позволяющих производить запись нескольких электрических сигналов одновременно. В первом варианте (рис. 1, б) модулятор представляет собой пластину фоторефрактивного кристалла, с одной стороны которой нанесены электроды в виде прозрачных проводящих полосок, а с другой стороны пластины нанесен один сплошной электрод. При такой конструкции модулятора управляющие напряжения прикладываются между соответствующими полосковыми электродами и общим электродом, напряжение U оказывается зависимым от x и y . Количество одновременно вводимых сигналов соответствует количеству полосковых электродов. Электроды создают в кристалле в основном продольное электрическое поле, т. е. направленное вдоль распространения считывающего света. Области кристалла, в которых создается электрическое поле, одновременно

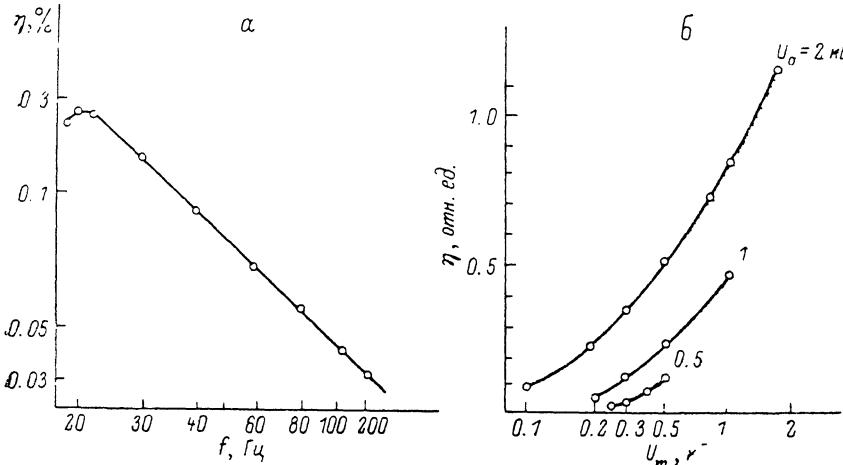


Рис. 2.

сканируются узкими световыми полосками. После записи под каждым электродом формируется пространственно-неоднородное распределение заряда. Поперечные компоненты электрического поля осуществляют модуляцию считывающего света за счет поперечного электрооптического эффекта.

Во втором варианте многоканального модулятора (рис. 1, в) полосовые электроды нанесены с одной стороны кристаллической пластины, а напряжения прикладываются между парами электродов, создающими в основном поперечные поля; модуляция считывающего света происходит, как и в первом варианте, за счет поперечного электрооптического эффекта.

Рассмотренные выше структуры многоканальных электрически управляемых модуляторов обладают, на наш взгляд, рядом функциональных преимуществ. Геометрия записи, т. е. расположение записанных сигналов в плоскости модулятора, определяется конфигурацией и расположением электродов на поверхности кристалла и может быть задана с большой точностью при изготовлении электродов фотолитографическим способом. Например, если электроды изготавливают в виде эквидистантных прямолинейных полосок (рис. 1, в), то обеспечивается высокая геометрическая линейность записи информации в плоскости модулятора.

Дополнительную гибкость рассматриваемому способу записи многоканальных сигналов предоставляет возможность независимого выбора скорости и момента начала сканирования в каждом канале модулятора.

Для экспериментального исследования электрически управляемой записи на фоторефрактивные кристаллы использовалась структура типа ПВМС ПРИЗ (пластина $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ в этом модуляторе имела срез [110] и толщину 500 мкм). К электродам структуры прикладывалось напряжение, промодулированное гармоническим сигналом частоты f

$$U(t) = U_0 + U_m \sin 2\pi ft. \quad (2)$$

В плоскости модулятора формировалось движущееся ($v=10$ мм/с) изображение световой полоски шириной $l \approx 10$ мкм ($\lambda=441$ нм). Таким образом, в модуляторе записывалось изображение одномерной синусоидальной решетки пространственной частоты $v=fv^{-1}$. Например,

при частоте электрического сигнала $f=200$ Гц пространственная частота записанной решетки $\nu=20$ лин./мм. Считывание осуществлялось параллельным пучком линейно-поляризованного света Не—Не лазера ($\lambda=0.63$ мкм). Измерялась интенсивность 1-го дифракционного порядка. На рис. 2, а представлена зависимость дифракционной эффективности τ от частоты f электрического сигнала ($v=10$ мм/с). Видно, что рабочая полоса частот (по спаду дифракционной эффективности в 10 раз) лежит в пределах от 20 до 200 Гц, что соответствует пространственным частотам от 2 до 20 лин./нм. Рис. 2, б показывает, что при фиксированной амплитуде управляющего напряжения U_m амплитуда модуляции считающего света возрастает с увеличением напряжения смещения U_0 .

В случае многоканальных ПВМС со структурой, показанной на рис. 1, в, электроды изготавливались фотолитографическим способом. Период электродов 250 мкм, что позволяло

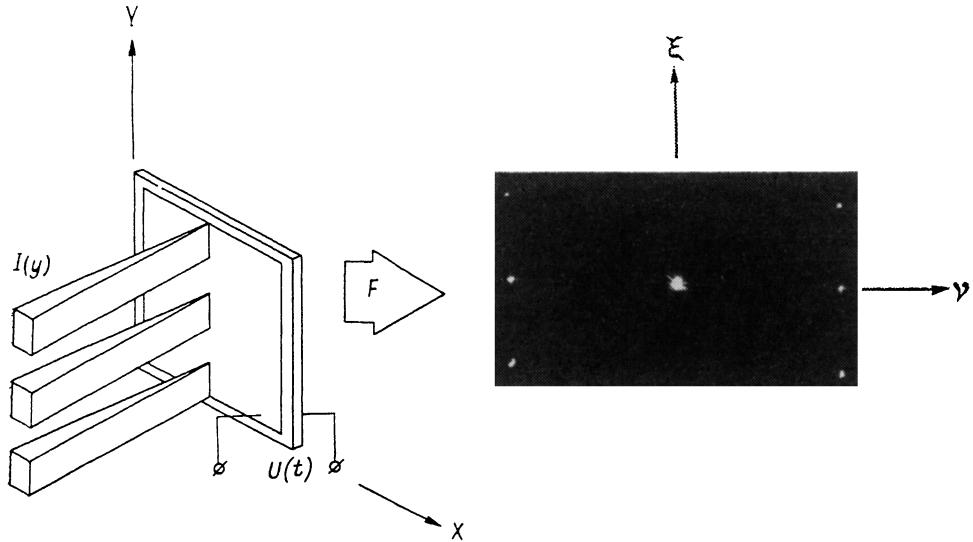


Рис. 3. Комбинированная оптико-электрическая запись: $U(t)=U_0+U_m \sin 2\pi ft$, $f=200$ Гц, $\nu=200$ лин./мм; $I(y)=I_0+I_m \sin \xi y$, $\xi=10$ лин./мм.

располагать 40 электродов на 1 см при расстоянии между электродами 125 мкм. В этом случае величина управляющего напряжения ограничивалась пробоем по воздуху и не превышала 200 В, что в свою очередь ограничивало максимально достижимую дифракционную эффективность.

Электрически управляемая запись не исключает возможности одновременно осуществлять и оптически управляемую запись на фоторефрактивные кристаллы. В работе реализована комбинированная оптико-электрическая запись информации. Для такой записи модулировалось прикладываемое к электродам напряжение $U(t)$ и одновременно модулировалась интенсивность сканирующего светового пучка. В этом случае записанное изображение представляет произведение электрического и оптического сигналов. На рис. 3 показан пример картины дифракции на изображении, полученным при перемножении двух гармонических сигналов с пространственными частотами 20 и 10 лин./нм. Сигналы записывались как ортогональные синусоидальные решетки. За счет анизотропии электрооптического эффекта

Параметры	Значения
Полоса рабочих частот (по спаду τ в 10 раз)	2–20 лин./мм или 2–200 Гц при $v=10$ мм/с
Управляющие напряжения: переменное постоянное смещение	100 В 1–2 кВ
Энергия «очувствляющего» света, $\lambda=0.44$ мкм	0.5 МД/см ²
Время памяти	10 с

в срезе [110] удается подавить дифракцию в направлении оси ξ [1]. При этом наблюдается отклик на сигнал, сформировавший решетку, волновой вектор k которой направлен вдоль оси v , а также дифракция на комбинационных пространственных частотах.

Таким образом, в работе продемонстрированы возможности электрически управляемой и комбинированной оптико-электрической записи на светочувствительные электрооптические ПВМС. Показано, что предложенные структуры модуляторов обладают новыми функциональными возможностями.

В таблице приведены основные параметры электрически управляемого модулятора со структурой ПВМС ПРИЗ на основе фоторефрактивного кристалла $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$. Как видно из таблицы, ПВМС на основе $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ требовал достаточно высоких управляющих напряжений. Однако управляющие напряжения могут быть существенно снижены, если предложенные способы записи реализовать на структурах оптически управляемых ПВМС типа ФОТОТИТУС, МДП-ЖК, которые требуют меньших рабочих напряжений.

Литература

- [1] Петров М. П., Степанов С. И., Хоменко А. В. Фоточувствительные электрооптические среды в голографии и оптической обработке информации. Л.: Наука, 1983. 270 с.
[2] Бережной А. А., Бужинский А. А., Брыксина И. В., Попов Ю. В. Тез. докл. II Всес. научно-техн. конф. «Проблемы развития радиооптики». М., 1985, ч. 2, с. 177.
[3] Васильев А. А., Компанетс И. Н., Парфенов А. В. Optik, 1984, v. 67, N 3, p. 223—236.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН ССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
16 декабря 1986 г.

УДК 621.384.6

Журнал технической физики, т. 58, в. 3, 1988

ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОКРАТНЫХ ИМПУЛЬСОВ ТОКА УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ ПИКОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Ю. Д. Черноусов, И. В. Шеболаев, В. М. Григорянц, В. В. Лозовой,
О. А. Анисимов

В [1] предложено формировать прореженные последовательности импульсов тока пикосекундного диапазона из ускоренного электронного пучка путем отклонения коротких сгуст-

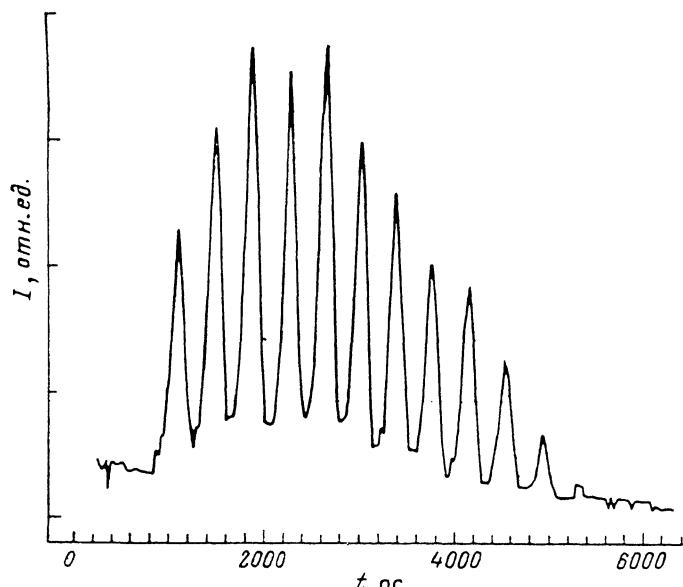


Рис. 1. Форма импульса тока на выходе ЛУЭ с выключенным дефлектором.

ков СВЧ дефлектором на частоте, отличной от частоты их следования. При использовании этого метода возможно формирование также и однократных импульсов пикосекундной дли-